

Eigenschaften optischer CCDs

Gruppe 1

Udo Beier

Leon Brückner
Sebastian Ziegler

Valentin Olpp

März 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	4
2	Einleitung	5
3	Methoden	6
3.1	Halbleiter	6
3.2	Aufbau und Funktion eines CCD-Chips	6
3.3	Bildfehler und -korrekturen	6
3.4	Der Gain-Faktor	9
3.5	Durchführung	10
4	Ergebnisse	11
5	Diskussion	16
6	Anhang	17

Abbildungsverzeichnis

1	Auftragung von Dunkelstrom über der CCD-Temperatur	11
2	Aufnahme eines bias frame	12
3	Auftragung des gemessenen ADU-Wertes über der einfallenden Lichtintensität	13
4	Aufnahme der Diode bei extremer Überbelichtung	14
5	Erste Aufnahme nach Belichtungsbeginn	14
6	Zweite Aufnahme	15
7	Aufnahme nach Einführen des Blattes	15

Tabellenverzeichnis

1	Messwerte für den Dunkelstrom in Abhängigkeit der CCD-Betriebstemperatur	17
2	Messung des Gain-Faktors für verschiedene Belichtungszeiten	17
3	Gemessener ADU-Wert über dem Anteil des transmittierten Lichts	18

1 Abstract

Zur Untersuchung der Eigenschaften optischer CCDs wurden der Zusammenhang zwischen Dunkelstrom und Temperatur des CCD-Chips, der Gain-Faktor der verwendeten Kamera sowie der Zusammenhang zwischen Lichteinfall und ADU-Output überprüft, daneben wurden bias frames aufgenommen und die Effekte „smear“ und „blooming“ untersucht. Es konnte in Näherung exponentieller Zusammenhang zwischen Dunkelstrom und Temperatur, sowie ein kaum von der Belichtungszeit abhängiger Gain-Faktor $\bar{g} = 1.940 \pm 0.04 \frac{\text{adu}}{\text{e}}$ beobachtet werden. Der Zusammenhang zwischen Lichteinfall und ADU-Output ergab sich in Näherung als linear, allerdings sichtbar fehlerbehaftet.

2 Einleitung

Zu Beginn der Photographie im 19. Jahrhundert wurden Photoplatten verwendet, um optische Eindrücke festzuhalten. Diese waren etwa mit Silbernitrat beschichtet und verfärbten sich je nach Stärke des Lichteinfalls unterschiedlich dunkel, desweiteren waren aufwendige chemische Prozesse notwendig, um eine weitere Verdunklung bei Lichteinfall nach der gewünschten Belichtungszeit zu verhindern. Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde dieses Prinzip von digitalen Aufnahmemethoden abgelöst, die insbesondere den Vorteil bieten, dass sie im Gegensatz zu den teuren Photoplatten mehrmals verwendbar sind.

Ein Beispiel für solche Technologie ist der CCD-Chip, der heute neben dem CMOS-Elementen für digitale Aufnahmen verwendet wird. Ein solcher CCD-Chip besteht aus Halbleiterelementen, in denen bei Lichteinfall Ladung ausgelöst wird, die anschließend ausgelesen und in ein digitales Signal umgewandelt werden kann.

In diesem Versuch sollen die Eigenschaften von CCDs näher untersucht werden. Insbesondere wird dabei auf gängige Methoden zur Bildverbesserung sowie auf Effekte, die sich aus dem Ausleseprozess ergeben, eingegangen.

3 Methoden

3.1 Halbleiter

Halbleiter sind besondere Elemente mit vier Valenzelektronen, das bekannteste Beispiel hierfür ist der Halbleiter Silizium. Sie können durch Einbringen von Fremdatomen mit drei (p) oder fünf Valenzelektronen (n) „dotiert“ werden. Die hat zur Folge, dass der dotierte Halbleiter zwar elektrisch neutral ist, sich allerdings Unregelmäßigkeiten im Metallgitter ausbilden, sodass ein Wird ein Atom mit fünf Valenzelektronen eingebracht, so existiert im regelmäßigen Siliziumgitter kein freier Platz für das Elektron, sodass es HIER FEHLT NOCH ZEUG

3.2 Aufbau und Funktion eines CCD-Chips

Ein CCD-Chip setzt sich aus einer rechtecksgitterförmigen Anordnung von Halbleiterelementen, sogenannten Pixeln, zusammen. An diesen liegt eine Spannung in Sperrrichtung an, sodass zunächst kein Strom fließen kann. Wird der Halbleiter allerdings mit Photonen hinreichend großer Energie bestrahlt, so kann das Photon ein oder mehrere Paare von Elektronen und Löchern aus dem Gitter lösen, die schließlich in einem Potenzialtopf gesammelt werden.

Die einzelnen Pixel sind spaltenweise gegeneinander isoliert, allerdings nicht zeilenweise. Durch Anlegen einer Sägezahnspannung an die Spalten werden die in den Potenzialtöpfen während der Beleuchtung des Chips gesammelten Elektronen während dem Ausleseprozess Zeile für Zeile in Ausleserichtung verschoben. Am Rand des Gitters befindet sich in Ausleserichtung die Ausleseelektronik, die die Ladungsmenge pro Pixel misst und digitalisiert. Dieser Ausleseprozess kann nicht immer sämtliche Ladungen um ein Pixel verschieben, sodass er eine Quelle von Bildfehlern darstellt.

Dieser Ausleseprozess finden nicht instantan statt, sondern erfordern eine gewisse Zeitspanne, was zu verschiedenen Bildfehlern führt.

3.3 Bildfehler und -korrekturen

CCD-Kameras zählen die auf den Chip auftreffenden Photonen und rechnen diese in ein Signal um. Dabei ist jedoch zunächst zu beachten, dass Photonen nicht gleichmäßig auf den Chip auftreffen, sondern zufällig verteilt. Wenn man also mehrere Bilder aufnimmt, bekommt man auch mehrere Werte für jeden Pixel. Dies wäre bei herkömmlichen, z.B. tagsüber aufgenommenen Bildern egal, da dort enorm viele Photonen auftreffen und die kleinen Variationen keinen Unterschied machen. Die Zahl der auftreffenden Photonen bei astronomischen Aufnahmen ist aber so gering, dass die zufälligen Variationen großen Einfluss nehmen. Man kann also bei mehreren Bildern für jeden Pixel einen Mittelwert und eine Standardabweichung (auch 'noise' genannt) für die Photonenzahl bestimmen. Anhand dessen wird ein Maß für die Qualität eines Bildes definiert, die 'Signal-to-noise ratio' (SNR) $\frac{\bar{x}}{\sqrt{\bar{x}}} = \sqrt{\bar{x}}$. Daraus lässt sich auch erkennen, dass eine größere Anzahl detektierter Photonen eine bessere Bildqualität liefert.

Die reine statistische Varianz der ankommenden Photonen ist aber nicht die einzige

Quelle für Fehler bzw. Abweichungen. So ist der von der CCD-Kamera ausgegebene Wert für jeden Pixel nicht einfach die Zahl der detektierten Photonen, sondern ein Wert in einer nicht näher definierten Einheit (genannt 'analog-to-digital unit' oder ADU). Der Zusammenhang zwischen den gelösten Elektronen und dem Wert in ADU heißt 'Gain-Faktor' g . Es ist insbesondere nicht klar, ob ein Wert von 0 ADU auch 0 detektierten Photonen entspricht, so besitzen die meisten Kameras einen Offset (genannt 'bias'), der vom Messwert abgezogen werden muss. Dieser Offset kann bestimmt werden, indem ein 'bias frame', also ein Bild mit minimaler Belichtungszeit aufgenommen wird. Dieser 'bias frame' muss dann vom eigentlichen Bild abgezogen werden, um ein korrektes Ergebnis zu erhalten. Ein weiterer Effekt der Signalwandelelektronik ist der 'readout noise', eine konstante Unsicherheit, die ihren Ursprung in den Verstärkerschaltkreisen hat.

Der CCD-Chip selbst ist auch eine Fehlerquelle. Defekte im Kristallgitter der Halbleiterstruktur führen zu 'hot pixels' (zu kleine Bandlücke, sodass immer Elektronen herausgelöst sind), 'dead pixels' (zu große Bandlücke, sodass nie Elektronen herausgelöst werden), außerdem führen thermische Effekte (nicht ausreichende Kühlung) ebenfalls dazu, dass Elektronen gelöst werden, ohne dass ein Photon auf den Chip auftrifft. Die thermischen Effekte und 'hot pixels' können mittels einer 'dark frame'-Aufnahme, also einer Aufnahme mit identischer Belichtungszeit zur eigentlichen Aufnahme, aber ohne Lichteinfall (z.B. mit geschlossenem Shutter), korrigiert werden. Auf dem 'dark frame' sind also nur die Fehler des Chips zu sehen, die dann vom eigentlichen Bild abgezogen werden können. Da die Auslösung der Elektronen durch thermische Effekte aber auch ein Zufallsprozess ist, kommt durch die 'dark frame'-Aufnahme eine weitere Unsicherheit hinzu ('dark current noise'). 'Dead pixels' können in der Nachbearbeitung behoben werden, indem der Wert des defekten Pixels als Mittelwert der beiden benachbarten Pixel berechnet wird.

Der dritte wichtige Faktor, der das Bild verfälschen kann, ist der eigentliche optische Aufbau, (d.h. Teleskop, Okular, Filter, etc.) Reflexionen, Staub usw. erzeugen auf dem Bild sichtbare Artefakte. Um diese zu entfernen, wird ein 'flat field' aufgenommen, ein homogen ausgeleuchtetes Bild. Dieses Bild sollte möglichst hell sein (also eine große signal-to-noise ratio besitzen), um wenig zusätzliche Unsicherheiten in das fertige Bild einzubringen. Außerdem kann noch ein 'flat dark frame' aufgenommen werden, der dann vom flat field abgezogen wird. Die eigentliche Aufnahme (die schon mittels bias und dark frame verbessert wurde) wird schließlich mit dem flat field gewichtet (d.h. dadurch geteilt).

Die vorhin schon angesprochenen statistischen Betrachtungen (signal, noise) haben eine wichtige praktische Bedeutung, die hier noch kurz angesprochen werden soll.

Das gesamte detektierte Signal (in ADU) in der ursprünglichen Aufnahme S_{raw} ist gegeben durch

$$S_{raw} = \frac{x}{g} + \frac{x_d}{g} + b \quad (1)$$

wobei x die Anzahl der detektierten Elektronen, x_d der Dunkelstrom, also die Anzahl der durch CCD-Effekte herausgelösten Elektronen, g der Gain-Faktor und b der Bias ist. Die gesamte Unsicherheit σ_{raw} (in ADU) der ursprünglichen Aufnahme berechnet sich

durch

$$\sigma_{raw} = \frac{\sqrt{\sigma^2 + \sigma_d^2 + \sigma_{ron}^2}}{g} \quad (2)$$

wobei σ die Standardabweichung der detektierten Elektronen, σ_d der dark current noise und σ_{ron} der readout noise ist.

Diese Formeln gelten entsprechend auch für den dark frame und das flat field. Die praktische Anwendung zeigt sich, wenn man mehrere Bilder aufnimmt (um ein Mittel zu erzeugen). Die resultierende Signalstärke und Abweichung ergibt sich dann zu:

$$S_{combined} = \frac{N_{raw} S_{raw}}{N_{raw}} - \frac{N_{dark} S_{dark}}{N_{dark}} = S_{raw} - S_{dark} \quad (3)$$

$$\sigma_{combined} = \sqrt{\frac{\sigma_{raw}^2}{N_{raw}} + \frac{\sigma_{dark}^2}{N_{dark}}} \quad (4)$$

Man sieht, dass die Signalstärke nicht von der Anzahl N der Aufnahmen abhängt, wohl aber die Abweichung. Je mehr Bilder man verwendet, desto kleiner wird die Abweichung, also wird die signal-to-noise ratio größer. Mit diesen Formeln kann man abschätzen, wie viele Aufnahmen angefertigt werden müssen, um eine gewünschte Bildqualität zu erhalten. Eine SNR von 3 liefert ein unklares und stark körniges Bild, während eine SNR von 30 bereits ein scharfes und deutliches Bild ergibt. Bei einer SNR von 100 kann man sogar kleine Details klar erkennen und Nebel- und Staubwolken gut sichtbar und scharf abbilden.

Noch zu bedenken ist, dass durch die flat field - Korrektur zusätzliche Unsicherheit hinzukommt. Der Einfluss auf die resultierende Bildqualität ist wegen der sehr hohen SNR der flat field - Aufnahme jedoch üblicherweise vernachlässigbar, insbesondere anhand der enormen optischen Aufwertung des Bildes durch die Korrektur. Die resultierende SNR berechnet sich aus:

$$SNR_{result} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{SNR_{image}^2} + \frac{1}{SNR_{flatfield}^2}}} \quad (5)$$

Ein letzter, wichtiger Aspekt für astronomische Aufnahmen ist der Einfluss der Lichtverschmutzung, der durch die OSR ('object-to-sky ratio') beschrieben wird. Dieser kann in städtischen Gebieten (also auch in Bamberg) sehr groß sein, ist aber für diesen Versuch irrelevant.

„Blooming“ und „Smear“ sind zwei weitere Effekte, die bei Aufnahmen mit CCD-Chips auftreten können. „Blooming“ bezeichnet den Effekt, dass Pixel im CCD-Chip überbelichtet werden, sodass Elektronen in benachbarte Pixel wandern. Dies führt zu einem hellen Schein um das überbelichtete Pixel herum.

Beim sogenannten „Smear“ muss der Shutter deaktiviert sein. Es kommt während des Auslesevorgangs zu weiterer Belichtung der Pixel, sodass in der stark belichteten Spalte ein heller Streifen wahrnehmbar ist.

3.4 Der Gain-Faktor

Es gilt: Für die Berechnung des Gain-Faktors ergibt sich:

$$\sigma_{EL} = g \cdot \sigma_{ADU}, \quad (6)$$

$$N_{EL} = g \cdot N_{ADU} \quad (7)$$

und

$$\sigma_{EL} = \sqrt{N_{EL}}. \quad (8)$$

Aus 6 ergibt sich:

$$\sigma_{EL}^2 = N_{EL}, \quad (9)$$

sodass gilt:

$$N_{EL} = g^2 \cdot \sigma_{ADU}^2 = g \cdot N_{ADU}. \quad (10)$$

Daraus ergibt sich:

$$g = \frac{N_{ADU}}{\sigma_{ADU}^2} \quad (11)$$

Zur möglichst genauen Berechnung des obigen Terms muss der Offset zwischen der N_{ADU} und N_{EL} bei der Aufnahme eines flat fields, der mittels bias frames ermittelt werden kann, herausgerechnet werden, sodass schließlich eine direkte Proportionalität zwischen $N_{ADU, ohneBias}$ und N_{EL} besteht. Da anschließend zwei systematisch gleiche Aufnahmen betrachtet werden, schreibt man:

$$N_{ADU, ohneBias} = \frac{N_{ADU}(A) + N_{ADU}(C) - \overline{B_1} - \overline{B_2}}{2}, \quad (12)$$

wobei $\overline{B_1}$ und $\overline{B_2}$ die Mittelwerte zweier bias frames sind, die ebenfalls systematisch gleich sind.

Für die Standardabweichung von $N_{ADU, ohneBias}$ ergibt sich:

Sowohl für $\sigma(A - C)^2$ als auch für $\sigma(B_1 - B_2)^2$ ergibt sich nach der in der Anleitung vorgeführten Rechnung, dass:

$$\sigma_{ADU, flat}^2 (stat) = \frac{\sigma_{ADU}^2 (A - C)}{2} \quad (13)$$

sowie

$$\sigma_{ADU, bias}^2 (stat) = \frac{\sigma_{ADU}^2 (B_1 - B_2)}{2}. \quad (14)$$

Da beide Standardabweichungen statistischer Natur sind, ist ihre Kovarianz Null, sodass gilt:

$$\sigma_{ADU, ohne}^2 (stat) = \sigma_{ADU, flat}^2 (stat) - \sigma_{ADU, bias}^2 (stat). \quad (15)$$

Durch Einsetzen ergibt sich nun:

$$\begin{aligned} g &= \frac{N_{ADU, ohneBias}}{\sigma_{ADU, ohne}^2 (stat)} = \frac{\frac{N_{ADU}(A) + N_{ADU}(C) - \overline{B_1} - \overline{B_2}}{2}}{\sigma_{ADU, flat}^2 (stat) - \sigma_{ADU, bias}^2 (stat)} = \frac{\frac{N_{ADU}(A) + N_{ADU}(C) - \overline{B_1} - \overline{B_2}}{2}}{\frac{\sigma_{ADU}^2 (A - C) - \sigma_{ADU}^2 (B_1 - B_2)}{2}} \\ &= \frac{N_{ADU}(A) + N_{ADU}(C) - \overline{B_1} - \overline{B_2}}{\sigma_{ADU}^2 (A - C) - \sigma_{ADU}^2 (B_1 - B_2)}. \end{aligned} \quad (16)$$

Diese Formel wird zur Berechnung des Gain-Faktors verwendet.

3.5 Durchführung

In diesem Versuch soll zunächst die ideale Betriebstemperatur für den CCD-Chip ermittelt werden, also die Temperatur, bei der der Dunkelstrom minimal ist. Dazu werden verschiedene Temperaturen eingestellt und dann ein dark frame aufgenommen und ausgewertet. Es ist zu beachten, dass sich die Temperatur erst einpendeln muss, bevor eine Messung durchgeführt werden kann.

Weiter sollen bias frames und flat fields aufgenommen werden, um hieraus einen Wert für den Gain-Faktor zu bestimmen. Dazu wird mit der CCD-Kamera das Bild eines mit einem Baustrahler weitgehend homogen ausgeleuchteten Blatts Papier an der etwa drei Meter von der Kamera entfernten Tür aufgenommen und ausgewertet. Es ist hier zu beachten, dass das Bild nicht überbelichtet sein darf, da es andernfalls zu unerwünschten Effekten wie etwa blooming kommen kann.

Schließlich soll der Zusammenhang zwischen der Intensität des einfallenden Lichts und dem ADU-Output des CCD-Chips untersucht werden, indem Filter verschiedener Stärke vor der CCD-Kamera montiert werden. Für sämtliche, auch durch mehrere Filter erzeugte, Filterstärken wird die Helligkeit einer aufgenommenen LED ausgewertet. Weiter werden die angesprochenen Effekte „blooming“ und „smear“ untersucht.

4 Ergebnisse

Zunächst wurden bei einer Belichtungszeit von 30 Sekunden dark frames bei verschiedenen Temperaturen des Chips aufgenommen, um die ideale Betriebstemperatur des CCD zu ermitteln. Hierbei ergaben sich die in Tabelle 1 dargestellten Werte, welche in Abb. 1 graphisch dargestellt sind. Hier wurde der Verlauf mit einer Exponentialfunktion

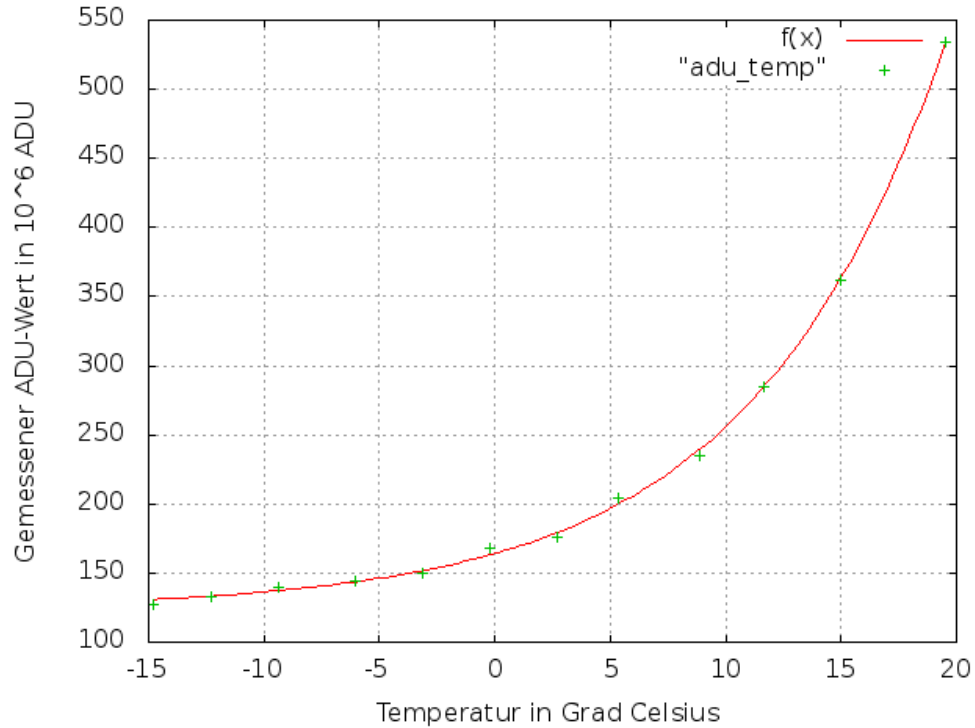


Abbildung 1: Auftragung von Dunkelstrom über der CCD-Temperatur

$f(T) = a \cdot \exp(T \cdot c) + b$ gefittet, welche theoretisch zu erwarten ist, da die Energie der Elektronen im Halbleiter prinzipiell boltzmann-verteilt ist.

Es ergibt sich also eine ideale Temperatur von etwa -15°C im betrachteten Intervall von -15 bis $+20^\circ \text{C}$. Eine tiefere Temperatur ist aufgrund der begrenzten Kühlleistung des CCD-Chips nicht erreichbar. Für die Fitparameter ergibt sich: $a = 40.0 \text{ adu}$, $c = 0.119 \frac{1}{\text{K}}$, $b = 124.2 \text{ adu}$.

Die Aufnahme eines bias frames bei einer Belichtungszeit von 0.12 s und einer Blendenöffnung von 5.6 wird in Abb. 2 dargestellt. Neben dem Rauschen im Hintergrund erkennt man mehrere senkrechte gepunktete Linien. Diese sind auf ein hot pixel in der entsprechenden Spalte zurückzuführen. Aufgrund des „schubweisen“ Auslesens der Zeilen, welches laut dem Betreuer durch Speicherüberläufe in der Ausleseelektronik verursacht wird, kommt es in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu einer Verzögerung beim Auslesen und somit zu hellen Punkten mit räumlich gleichem Abstand. Des weiteren ist ein leichter Helligkeitsgradient von links nach rechts sichtbar. Der Grund hierfür ist wahrscheinlich ein

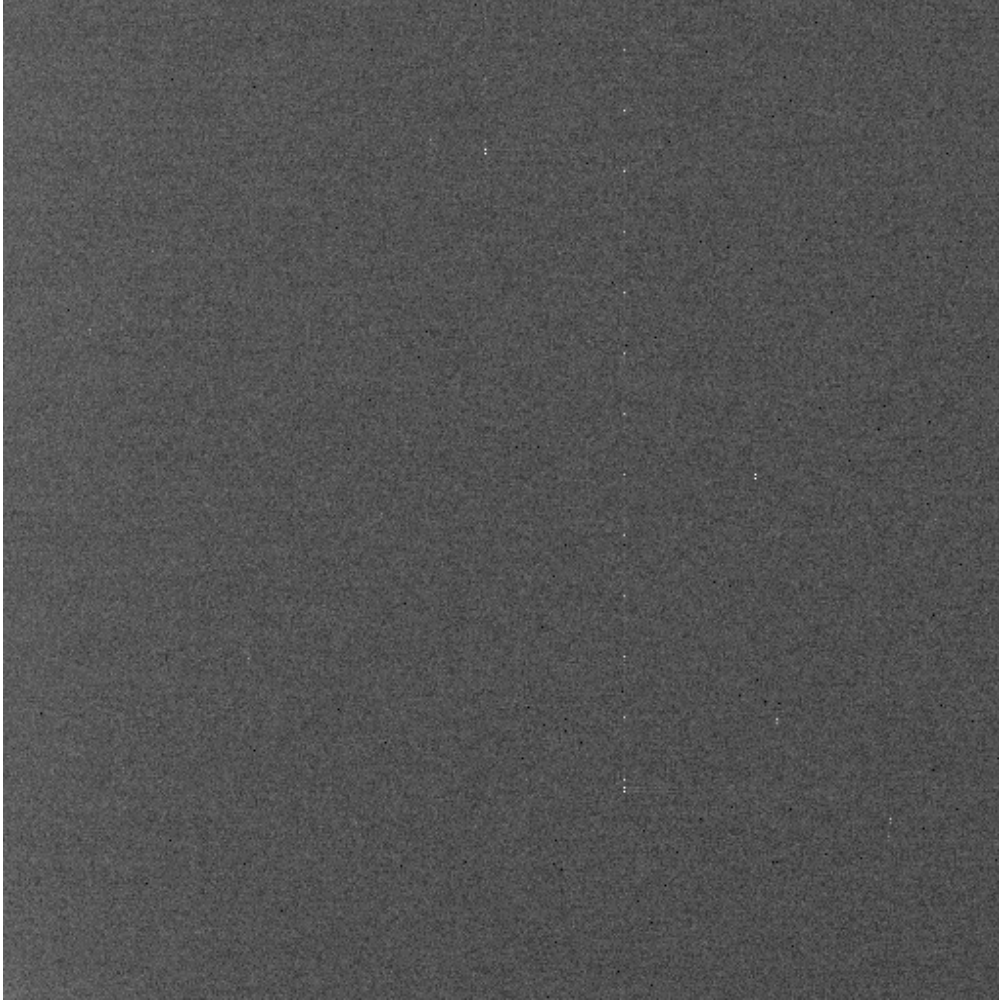


Abbildung 2: Aufnahme eines bias frame

Temperaturgradient im CCD-Chip und ein somit räumlich unterschiedlicher Dunkelstrom. Es wurden insgesamt 11 bias frames aufgenommen, deren mittlerer ADU-Wert sich zu 115.6 ± 1.07 ergibt.

Damit auch bei maximaler Belichtungszeit kein überbelichtetes Bild aufgenommen wurde, musste insgesamt ein Filter der Stärke 2048, der also nur $\frac{1}{2048}$ des Lichts transmittiert, verwendet werden. Zur Bestimmung des Gain-Faktors werden zu jeder Belichtungsdauer je zwei flat fields aufgenommen und ausgewertet. Dabei ergeben sich mit der Formel (16) die in Tabelle 2 dargestellten Werte. Als gemittelter Wert ergibt sich

$$\bar{g} = 1.940 \pm 0.04 \frac{\text{adu}}{\text{e}}. \quad (17)$$

Die Werte für den Gain-Faktor sind zwar alle im gleichen Bereich, es ist aber eine leichte Tendenz zu kleineren Gain-Faktoren bei größeren Belichtungszeiten erkennbar. Der Grund

hierfür dürfte in Fehlern, die sich in der statistischen Betrachtung zur Herleitung der Formel für den Gain-Faktor ergeben, liegen.

In Tabelle 3 sind die Werte für gemessenen ADU-Werte aufgetragen über dem durch die Filter transmittierten Licht als Anteil der Lichtintensität vor dem Filter. Plottet man die ermittelten Werte, so ergibt sich der in 3 dargestellte Verlauf. Werden die Datenpunkte mit der Funktion

$$f(x) = a \cdot x + b \quad (18)$$

gefittet, so ergeben sich die Werte $a = (119 \pm 5.0) \cdot 10^6 \text{ adu}$ und $b = (2.8 \pm 1.4) \cdot 10^6 \text{ adu}$. Problematisch ist, dass die Gerade die Punkte nahe der Null gut approximiert, die Werte

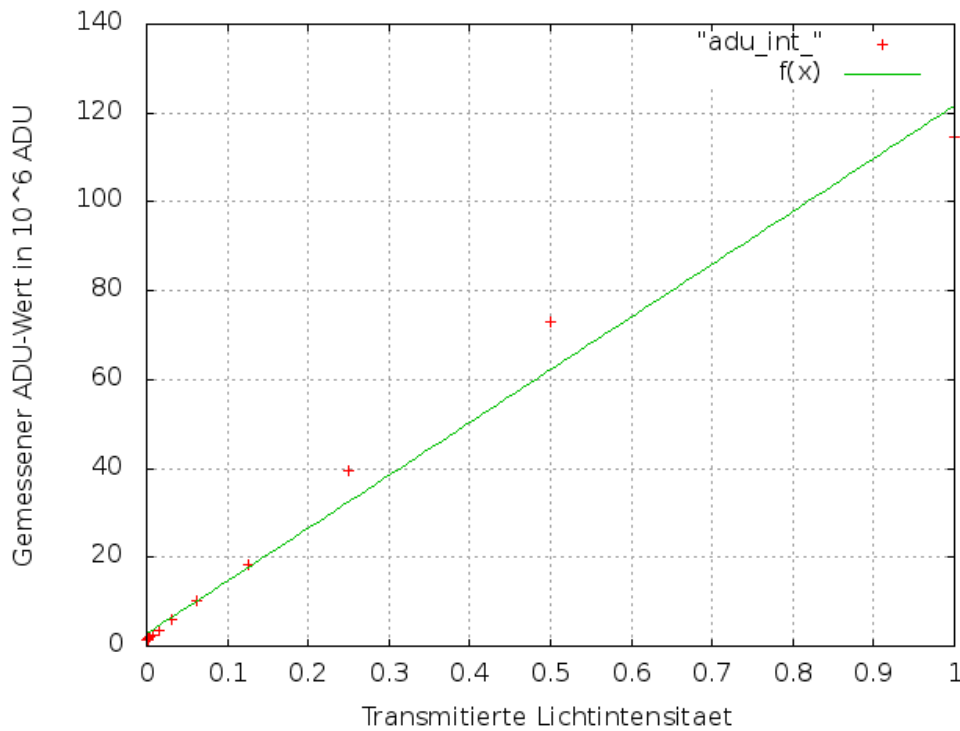


Abbildung 3: Auftragung des gemessenen ADU-Wertes über der einfallenden Lichtintensität

mit größerer Lichtintensität aber verfehlt. Grund hierfür ist die große Anzahl an Punkten nahe der Null, die folglich den Fit dominieren.

Schliesslich wurden die Effekte „smear“ und „blooming“ untersucht.

In 4 ist eine Aufnahme der Diode bei starker Überbelichtung dargestellt, was durch eine Belichtungszeit von 5 Sekunden und einer Blende von 8f erreicht wurde. Man erkennt, dass nicht nur die tatsächlich überbelichteten Pixel hell sind, sondern auch die spaltenweise benachbarten Pixel. Der Grund hierfür ist, dass die Potentialtöpfe der einzelnen Pixel schlicht „überlaufen“, sodass Elektronen in benachbarte Pixel wandern. Dies geschieht vor allem innerhalb der Spalten und nur wenig in den Zeilen, da diese gegeneinander

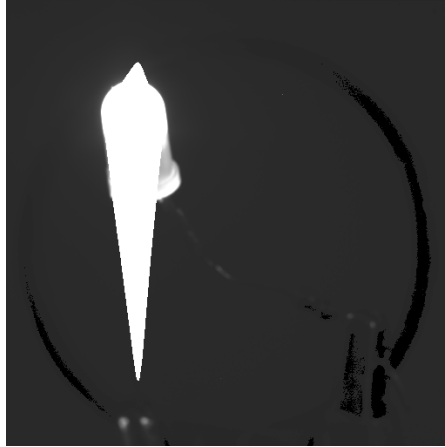


Abbildung 4: Aufnahme der Diode bei extremer Überbelichtung

isoliert sind. Im Gegensatz dazu werden die Elektronen in den Spalten verschoben, sodass diese nicht isoliert sein dürfen.

Zur Veranschaulichung des Smear-Effektes wurden Aufnahmen bei deaktiviertem Shutter, einer Belichtungszeit von 0.5 Sekunden und ebenfalls einer Blende von 8f von gemacht, wobei der Strahlengang zunächst durch ein Blatt Papier unterbrochen war, dass dann entfernt wurde. Die Ausselelektronik befindet sich hier am oberen Bildrand. Bei der ersten Aufnahme zeigte sich das in 5 dargestellte Bild.

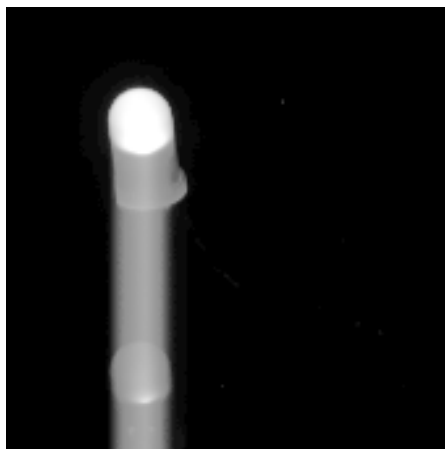


Abbildung 5: Erste Aufnahme nach Belichtungsbeginn

Der Effekt erklärt sich folgendermaßen:

Zu Beginn des Auslesens sind die ersten ausgelesenen Pixel unbelichtet. Wird das erste stark belichtete Pixel ausgelesen, so ergibt sich ein heller Punkt. Die nach diesem Pixel nachfolgenden Pixel werden während des zeitlich verzögerten Auslesens weiter belichtet,

sodass sie überbelichtet erscheinen. Diese Pixel liegen vom stark belichteten Pixel entgegen der Ausleserichtung.

Bei der zweiten Aufnahme ist dann ein durchgehender „smear“ erkennbar, was daran liegt, dass die Pixel vor dem stark belichteten Pixel noch während dem vorhergehenden Ausleseprozess belichtet werden. Somit erscheint ein durchgehend heller Strich in der Spalte. Dies ist in Abb. 6 dargestellt.

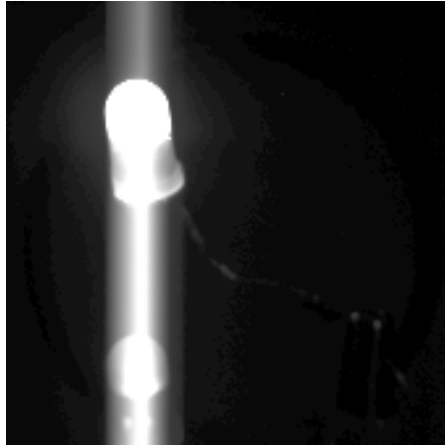


Abbildung 6: Zweite Aufnahme

Wird nun das Blatt Papier in den Strahlengang eingeführt, so ergibt sich die in Abb. 7 dargestellte Aufnahme.

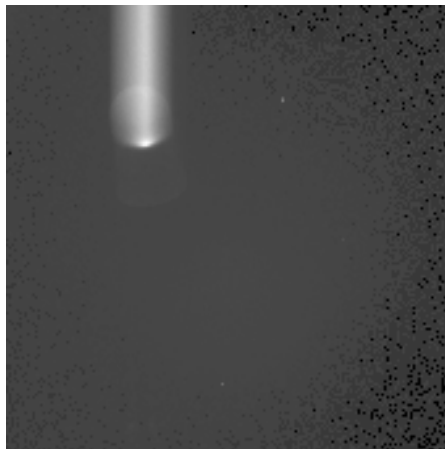


Abbildung 7: Aufnahme nach Einführen des Blattes

Der Grund dafür ist, dass die ersten Pixel wiederum während des vorherigen Auslesens belichtet werden und somit hell erscheinen. Nach dem Einführen des Blattes in den Strahlengang werden keine weiteren Pixel belichtet, sodass der helle Streifen an einer durch den Zeitpunkt des Einbringens des Blattes definierten Stelle abbricht.

5 Diskussion

Für die ideale Betriebstemperatur des CCD-Chips ergab sich hier ein Wert von $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, der allerdings durch die eingeschränkte Kühlleistung der Kamera nach unten beschränkt ist. Würde man eine verbesserte Kühlung verwendet, so wäre eine tiefere Temperatur und wahrscheinlich auch ein noch geringerer Dunkelstrom zu erwarten.

Der geplottete Verlauf entspricht weitgehend den theoretischen Erwartungen:

Die Elektronen im Halbleitermaterial sind boltzmann-verteilt, die Anzahl pro Energie und Temperatur geht also mit $\exp(-\frac{E}{k \cdot T})$. Der exponentielle Anstieg des Dunkelstroms mit der Temperatur findet sich auch im entsprechenden Plot wieder.

Der offset der Exponentialfunktion ist wahrscheinlich auf den bias des CCD-Chips zurückzuführen, also den ADU-Wert, der auch bei minimaler Belichtungszeit und geschlossener Blende messbar ist.

Bei der Berechnung des Gain-Faktors ergibt sich zwar eine Tendenz bei unterschiedlichen Belichtungszeiten, allerdings ist der Fehler des Gain-Faktors verhältnismässig klein. Für eine Verbesserung der Bestimmung des Gain-Faktors dürfte eine genauere Aufschlüsselung der Beiträge zur Streuung hilfreich sein, sodass eine genauere Bestimmung von σ^{stat} möglich sein dürfte.

Bei der Betrachtung des ADU-Outputs über der Intensität des eingestrahnten Lichts ergibt sich in guter Näherung eine lineare Abhängigkeit. Allerdings sind die ADU-Werte für grössere Intensitäten geringer als durch Interpolation des linearen Verlaufs zu erwarten wäre. Grund hierfür kann sein, dass bei großen Intensitäten einige Pixel der Aufnahme doch überbelichtet sind, sodass hier der ADU-Wert konstant bei dem Maximalwert von etwa 65500 liegt. Des weiteren wurde bei der Auswertung ein Rechteck, das genau die Diode einschloss, betrachtet und aufintegriert. Hierbei ist zunächst der von der von der eingestrahnten Intensität unabhängige Dunkelstrom ein Fehler, der insbesondere bei geringen Helligkeiten eine zunehmend große Rolle spielt. Weiter ist es bei den kaum belichteten Aufnahmen schwierig, die Diode exakt „einzurahmen“, sodass hier unterschiedliche Bereiche betrachtet werden. Dieser Fehler könnte vermieden werden, indem man leichte Störungen der Anordnung von Diode und Kamera verhindert und anschließend immer den gleichen Bildausschnitt betrachtet. Eine weitere Fehlerquelle können auch die Filter sein, die möglicherweise nicht exakt den angegebenen Absorptionsgrad aufweisen.

Eventuell könnte die Messung verbessert werden, indem man statt einer Diode mit großem Helligkeitsgradienten eine homogen ausgeleuchtete Fläche verwendet, da hier überbelichtete Pixel verhindert werden können. Des weiteren wäre es sinnvoll, von den Diodenaufnahmen einen passenden dark frame zu subtrahieren, sodass der Dunkelstrom keinen Fehler mehr liefert.

Tatsächlich liefert der Versuch aber das erwartete Ergebnis.

6 Anhang

Temperatur in $^{\circ}$ C	N_{ADU}	σ_{ADU}
19.52	534.599	1.277
14.96	361.729	0.919
11.63	285.273	0.734
8.87	234.327	0.621
5.33	204.370	0.551
2.73	176.372	0.481
-0.23	168.276	0.448
-3.16	150.341	0.405
-6.06	144.344	0.387
-9.37	139.575	0.347
-12.29	133.011	0.316
-14.81	127.119	0.294

Tabelle 1: Messwerte für den Dunkelstrom in Abhängigkeit der CCD-Betriebstemperatur

Belichtungszeit in s	Gain-Faktor
6.0	1.848
5.0	1.872
4.0	1.883
3.0	1.901
2.0	1.933
1.0	2.100
0.5	2.032

Tabelle 2: Messung des Gain-Faktors für verschiedene Belichtungszeiten

Anteil des transmittierten Lichts	aufintegrierter ADU-Wert der Diode in $10^6 ADU$
1	114.57
0.5	72.831
0.25	39.488
0.125	18.205
0.0625	10.329
0.03125	5.9369
0.015626	3.4533
0.0078125	2.5956
0.00390625	2.013
0.001953	1.664
0.00097656	1.5182
0.00048828	1.479
0.0002441	1.368
0.00012207	1.275

Tabelle 3: Gemessener ADU-Wert über dem Anteil des transmittierten Lichts

Literatur

[Ast] Astronomisches Praktikum. Modul „Einführung in die Astronomie“. Dr. Karl Remeis Sternwarte. Bamberg

[Pho] <http://de.wikipedia.org/wiki/Fotografie>

[Wik] <http://de.wikipedia.org/wiki/CCD-Sensor>

[Ber] The Handbook of Astronomical Image Processing, Richard Berry, James Burnell, Willmann-Bell 2006.